X線天文衛星用の X線CCD/X線SOIの開発

鶴 剛 (京大理)

ICIE

tsuru@cr.scphys.kyoto-u.ac.jp

20241125_astroinst_CCD_SOI_v2

Self Introduction

- ・Takeshi Go TSURU (鶴 剛 / ツル タケシ)
 - Cosmic Ray Group, Physics, Kyoto University (京都大学 理学部 物理)
 - X-ray Astronomy. Observational Study on High Energy Objects
 - Developments of X-ray Detectors and X-ray Satellites
 - http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/tsuru/index.html
 - tsuru@cr.scphys.kyoto-u.ac.jp 075-753-3868



Major X-ray Astronomical Satellites



X-ray Imaging System



Detection of Visible light and X-rat photon

- Both visible light and X-rays can be detected by silicon image sensors.
- However, there are differences.

Visible light:

• One visible light photon \Rightarrow one e-h pair.

X-ray photon:

- One X-ray photon \Rightarrow multiple e-h pairs.
- The number of e-h pairs ∝ X-ray energy (3.65 eV / 1 e-h pair).
- By measuring the signal charge, we can measure its energy.





Energy-resolved X-ray photon-counting





- Detect an X-ray photon as one-by-one event.
- Measure position, energy and time of each X-ray event.
- Typical observing time per object is one day.
- Make exposures of ~10^4 times.

Map of the number of X-ray events



http://chandra.harvard.edu/photo/2013/sn1006/

Histogram of energy (electron number) of X-ray events



<u>開発の歴史</u>



<u>厚い空乏層を持つ裏面照射型CCDの開発</u>

2000年 or 2001年
 宮崎さんとハワイ観測所でお話





- ・鶴:僕たちは厚い空乏層のCCDを開発しているんですが, 宮崎さんはどんなCCDを?
- ・宮:僕たちも厚い空乏層を持つ裏面照射型CCDを開発しているんですよ~
- ・鶴:おー,それは素晴らしい! X線天文用のを開発したいです!

・宮 & 鶴:一緒にやりましょう!

- (少なくともツルは)割と気楽な気持ちで「共同開発」を始めた
- 大まかなスペックを共有できることを確認
- ・2015頃まで定期的にHPKでのmeetingを開催。多分100回近い。
- ・評価結果の共有がメイン.
- 特に開発の分担などは決めずに,ゆるい感じで行った

<u>厚い空乏層を持つ裏面照射型CCD w/HPKさん</u>



- ・N型ウェハ(ホール収集)比抵抗 >10kΩcm
- ・バックバイアス 20~30V
- ・空乏層厚み 200µm 裏面照射(ただし裏面の構造は違う)
- ・ピクセルサイズ X線用:24µm□ 可視光:12µm□

9



2008年11月20日 - 京都新聞(夕刊) -





・裏面構造は違う、裏面からの暗電流が低いことは共通。

・可視光はARコートが必要。X線は1個のイベントに対する100%の電荷収集効率

だいたい同じ

<u>必要な性能</u>

数字は目安です.実際の仕様と 一般的な値が混ざっています

項目	決定要因	X線	可視光
エリア	(モザイク) 望遠鏡 (センサ) CCDプロセス	20 - 60mm⊟ 20 - 60mm	D=540mm (HSC)
	(バタブル) モザイク・パッケージ	3サイド	4サイド (HSC)
ピクセル	望遠鏡・チャージシェア 転送速度(CTE)・データ量	20 - 40µm	~15 µm
ノイズ	エネルギー分解能 CCD読み出しアンプ	< 6e (rms)	似たような値 X線の方が厳しい感触 結局はプロセスで決まる
暗電流	1回の露光<<読み出しノイズ	< 0.1e/pix/s	長露光時間 ⇒ 厳しい要求 < 5e/pix/hr = 1e-3e/pix/s
フルウェル	40 keV X線が作る電荷量	10ke-	明るい星も暗い星を同時観測 大ダイナミックレンジ.〜150ke-
転送速度	パイルアップしないサイクル (1-10秒)で読む必要がある	~100kHz	一般的には、もう少し 低い転送速度で良いはず
電荷転送	分光性能	CTI << 1e-5	値はほぼ変わらないと思うが, 低い転送速度で達成すれば良い

細かい違いはあるが,だいたい同じ

<u>パッケージや読み出し</u>







4枚

41kg





116枚





Limitation due to low time resolution of CCD (~1sec) [14]

- Unable to take advantage of the performance of the latest X-ray telescope that provide large X-ray collecting area and high angular resolution.
 - Event pileup occurs due to slow readout. Energy-resolved photon counting is impossible.



- Unable to resolve fast variability of compact objects such as blackholes and neutron stars, which requires better than 30µsec (=10km/c).
- Unable to apply anti-coincidence technique using anti-counter
 - Unable to make use of the excellent performance of Si in the band above 10 keV due to the high detector background
 - The technique requires time resolution better than 10μ sec.

High time resolution better than **10µsec** is Key to open the next generation of X-ray Astronomy

X-ray SOIPIX - "XRPIX"

Developed in collaboration with 16 universities and organizations

Kyoto University, University of Miyazaki, Tokyo University of Science, Hiroshima University, Konan University, Kindai University, Nara University of Education, Osaka University, ISAS/JAXA, Kanto Gakuin University, University of Tokyo, KEK, Ibaraki University, Sendai College, Shizuoka University, D&S Incorporated













Trigger Output Event-Driven Readout

Conventional type of CCD and CMOS

Column readout (1kpixel)



- time resolution 1msec. dose not meet.
- only a few pixels have X-ray events
- almost all the pixels are empty
- However, must read out all the pixels
- data rate = pixel readout rate
 ⇒ reaches 1GHz



- read out X-ray hit pixels only
- time resolution better than 10μ sec
- data rate = X-ray event rate
 ⇒ 1kHz at the maximum
- Power consumption at post-stage date processing \propto data rate
- Event Driven readout reduces power cost

SOI-CMOS image sensor (SOIPIX)

17



- fine imaging (small pixel size $\sim 20 \mu$ m, large size > 20mm)
- low noise (< 10e rms),
- on-chip signal processing (high speed CMOS)
- wide-band, high quantum efficiency (thick depletion max 500 μ m, backside < 1 μ m)



Improvement of Spectral Performance in Frame Mode 19



XIRPIXI Pixel and Readout Circuits



20

PDD (Pinned Depleted Diode) Structure 21



Conventional Single SOI

- large n-well connected to the sense node to collect signal charge, and to suppress the back-gate effect of Tr. against the high backbias voltage.
- a large sense node capacitance (C_{sense})
 → not easy to achieve low readout noise
- causes capacitive coupling and interference between pixel circuit and sensor layer
 → degrade spectroscopy performance



Pinned Depleted Diode (Kamehama+18)

- pinned p-well is formed under the interface of insulator and sensor layers
- the pinned p-well suppresses
 - interference between pixel circuit and sensor layers
 - dark current from the interface between the sensor and insulator layers
- small sense node capacitance (C_{sense})
 - → easier to achieve low readout noise

Imaging in Event-Driven Mode (2G / XRPIX5b) 22



Cd-109,Vbb=10V, Room Temp.

Capability of event rate > 500Hz

Trigger delay and time resolution better than 10us using laser.

Spectral Performance of Large Device

XRPIX11 - the latest large device

Imaging Area : 21.3mm x 13.2mm Pixel Size : 36µm x 36µm Format : 592 (H) x 368 (V) $T = -20^{\circ}C$

 $V_{BB} = -300V$

full depletion of 300µm



20241022_LGX_miyazaki_fuchita.pdf





- The energy resolution is almost identical to that with an external ADC.
 The on-chip ADC has sufficient performance.
- Developing new devices equipped with DACs and pattern generator.

<u>イメージセンサの開発</u>

26



<u>SOIPIXコラボレーション</u>

- 2005年からKEK新井先生が開始
 - 素核半導体検出器 : Strip → Pixel, Hybrid → Monolithc
 - CCD, バルクCMOS, DEPFET等と比較し, SOIを選択
- 2007年からツルは参加
- 2013-17年度 新学術領域「量子イメージング」多分野が結集
 - 素核,放射光,天文・宇宙,質量分析,プロセス,集積回路
- 年1回のMPWラン: それぞれ予算と設計を持ち寄り, 合同で素子プロセスを行う
 - 要素回路, デバイス構造などを情報交換し, 自分の素子を設計する
- 2-3ヶ月に1回のLapis Meeting, 年1回のf2fのSOI研究会, 2週毎の zoom Meeting...

X線SOI「XRPIX」の開発

- 2008年 既存の素子を借りての評価からはじめた
- 2010年 科研費をとって自分の素子 XRPIX1 を作った
- KEKに相当助けて頂いた。汎用の読み出し回路が準備されているのは大きかった
- 12モデル, 20近い設計を投入. 30本以上の投稿論文 (2.5本/年)
- 現在 XRPIX collaboration 16機関, 61名
- X線天文 + MeVコンプトン(医療用, 宇宙用) + 暗黒物質 + 中性子・ミュオン...





<u>共同開発はどんな感じだったか</u>

 CCD: X線・光赤外 + HPKの共同開発 素子のスペックは大体同じ 「特定のセンサ」の共同開発 設計と製造はHPKさん ⇒ リスクは低い 	 研究者間の協力関係 評価をそれぞれの観点で行う 空乏層をX線 or 赤外で決める 不得意な評価をお互い補う 困ったときの相談相手 似て非なる部分の勉強になった
 SOI: 異分野間の共同開発 SOIは未知のデバイス・全く違う素子 「SOIセンサの作り方」の共同開発 全部自分でやる・製造のみラピスさん ウェハメーカとの交渉も必要 好きにできるが、動作保証なし ⇒ ハイリスク・コスト大 	研究者間の協力関係 • MPWラン ⇒ コスト削減の鍵 • 設計データ・知見の共有 • 様々な評価方法 • 半導体工学とのコラボレーション • 違う粒子・違う測定量・違う回路 • 言葉が違う

SOIは大変だった. やって良かったし, とっても楽しい (まだ終わっていないけど)

- 基本的に全部自分で行う
- 研究者人生の全てを掛ける気概が必要
- 色々なバックグラウンドの仲間が必要
- 多くの様々な分野の方と知り合えた
- 勉強になったし、知識も増えた
- 新しいアイディアも出てくる

<u>違う分野の人との共同開発ってなんだろう?</u>

- やりたければやれば良いし, 無理に行うこともないと思う
- 結局は人間関係じゃないかなぁ
 - Win Win で Give & Take
 - •大きく妥協しなければいけないものは、共同開発できない.
 - •相手を尊重し、自分の出来ることをやる.
 - •お金はその時に持っているほうが出す.
 - •お金は一部.ソフト、回路、評価、色々できることはある
 - 学生同士の交流 ← 研究会の飲み会
- 軽いところで、相手のものを借りてスタートで良いと思う.
- •予算を一緒に取る。研究会を一緒にする。論文を一緒に書く。
- X線と光赤外で共同開発できるか?
 - 断言:少なくともイメージセンサは間違いなく「できます」
 - 出会いの場も作っています



- イメージング検出技術を議論する分野横断の研究会
- 可視光、赤外線、X線、ガンマ線などの光子、電子、中性子、分子、イオンなどの 量子線の検出・解析技術を議論
- •素粒子・原子核物理学、宇宙物理学、物質科学から生命科学、医学まで幅広い分野をカバー
- •理学・工学や産官学の連携を深化し、新たな展開を生む
- 学生の優れた発表には、 優秀発表賞を授与する
- 2018年から6回目. 大体毎年 9月後半の2日間. QBI2024 115名参加
- 来年(7回目)は静岡大学 (浜松)で開催予定. tennet や天文月報でもアナウンスしています

SOC		
常深博(大阪大学, チェア)	幸村孝由(東京理科大学)	松本浩典(大阪大学)
新井康夫(KEK)	高橋忠幸(東京大学 IPMU)	宮崎聡(国立天文台)
大久保雅隆(産総研)	鶴剛(京都大学)	安富啓太(静岡大学)
片山晴善(JAXA)	中村哲(東京大学)	山谷泰賀(QST)
倉知郁生(ディーアンドエス)	初井宇記(理研)	